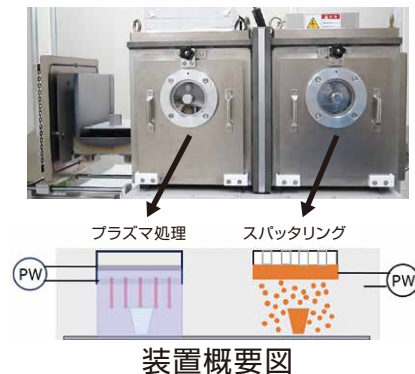


# New Generation PVD装置

## 次世代基板向け導体層形成

中真空域でのスパッタリング技術を使用し世界で初めて銅ダイレク成膜によるめっきシード層形成技術の開発をスタート(2014年8月)



### 特長

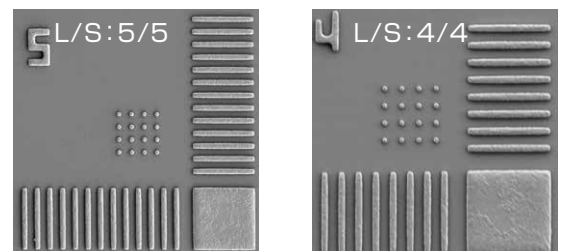
- 真空プロセスにも関わらず無電解めっきなど従来工法同等以上の生産性を実現
- HCDによる高い改質効果とめっきシード層などに適合した導体層膜形成が可能
- 有機絶縁材やガラスなどに銅ダイレクト成膜にて高い密着特性が得られる
- 高アスペクト比のTHや小径ブラインドビアへの導体層形成が可能
- Conventional PVD装置に比べ圧倒的な装置コスト競争力がある

### 適用例

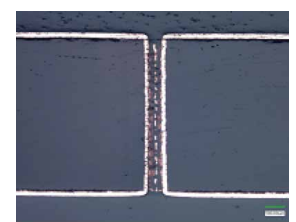
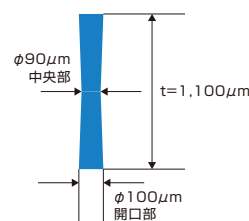
材 料	ピール強度
Alkali-free silica	~10
Borosilicate silica	~12
Synthetic fused silica	~7
Epoxy resin	~6
Polyimide	~12

#### 密着強度(N/cm) (ご参考)

90°引張試験 幅10mm 速度 50mm/min  
スパッタシード層+めっき20μm



回路形成例



TGV成膜例